
	<h2 style="color: red;">FQD13N06TF</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQD13N06TF</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 60V 10A DPAK</p> <p>Datenblätter: 1.FQD13N06TF.pdf 2.FQD13N06TF.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 10000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQD13N06TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 10A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	10000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 60V 10A (Tc) 2.5W (Ta), 28W (Tc) Surface
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 28W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7.5nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	310pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD13N06TF ist neu im Original, Suche FQD13N06TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD13N06TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD13N06TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQD13N10L F FQD13N10L F	 FQD13N06LTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A DPAK	 FQD13N10 FAIRCHI FQD13N10 FAIRCHI	 FQD13N06TF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 10A DPAK
 FQD13N06LTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A DPAK	 FQD13N06LTF AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A DPAK	 FQD13N06LTF Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 11A DPAK	 FQD13N06LTM-NL FAIRCHILD FQD13N06LTM-NL FAIRCHILD

heiße Teile

Mehr

⊕ FQD11P06TM	↔ FQD11P06TM	⇒ FQD12N10	D FQD12N20	⇒ FQD12N20L
⊕ FQD12N20LTF	⊕ FQD12N20LTF	D FQD12N20LTM	⇒ FQD12N20LTM	⇒ FQD12N20TF
⊕ FQD12N20TF	⊕ FQD12N20TM	⊕ FQD12N20TM	↔ FQD12P10	⇒ FQD12P10TF
D FQD12P10TF	⊕ FQD12P10TM	⊕ FQD12P10TM	⊕ FQD13N06	⇒ FQD13N06L
⇒ FQD13N06LTF	↔ FQD13N06LTF	⊕ FQD13N06LTM	⊕ FQD13N06LTM	⇒ FQD13N06LTM-NL
↔ FQD13N06TF	⇒ FQD13N06TM	D FQD13N06TM	⊕ FQD13N10	⊕ FQD13N10L
⊕ FQD13N10LTF	D FQD13N10LTF	⇒ FQD13N10LTM	↔ FQD13N10LTM	⇒ FQD13N10LTM-NL
⊕ FQD13N10TM	⊕ FQD13N10TM	↔ FQD13N20D	⇒ FQD14N15	⇒ FQD16N15
⊕ FQD16N25C	⊕ FQD16N25CTM	⊕ FQD16N25CTM	D FQD16N25L	⇒ FQD17N08
↔ FQD17N08L	⊕ FQD17N08LTF	⊕ FQD17N08LTF	⊕ FQD17N08LTM	⇒ FQD17N08LTM

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited